

# 2SD256, 2SD257, 2SD258, 2SD259

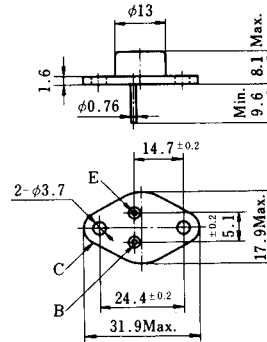
■シリコンNPN両面拡散形トランジスタ

- 一般用
- 通信産業用
- 指定通信工業用品種

■最大定格 (Ta=25°C)

項目	記号	2SD256	2SD257	2SD258	2SD259
コレクタ・ベース電圧	V <sub>CB0</sub>	60V	90V	110V	130V
コレクタ・エミッタ電圧	V <sub>CE0</sub>	40V	60V	80V	100V
エミッタ・ベース電圧	V <sub>EB0</sub>	6V			
コレクタ電流	I <sub>C</sub>	4A			
ベース電流	I <sub>B</sub>	1A			
許容コレクタ損失	P <sub>C</sub>	25W (フランジ温度25°C)			
接合部温度	T <sub>j</sub>	150°C			
保存温度	T <sub>stg</sub>	-65 ~ +150°C			

外形寸法 (単位: mm)  
JEDEC (TO-66), EIAJ (TC-16A, TB-23)



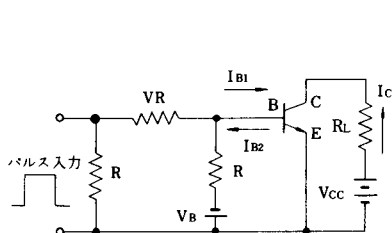
■電気的特性 (Ta=25°C)

項目	記号	試験条件	2SD256	2SD257	2SD258	2SD259
最大コレクタしゃ断電流	I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB</sub> = 20V	10μA			
最大エミッタしゃ断電流	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> = 5V	200μA			
コレクタ・エミッタ電圧	V <sub>CE0</sub>	I <sub>C</sub> = 50mA	40V	60V	80V	100V
直流電流増幅率	h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> = 4V I <sub>C</sub> = 1A	40Min. 80Typ.			
コレクタ飽和電圧	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> = 2A I <sub>B</sub> = 0.4A	1.0V Max. 0.2V Typ.			
しゃ断周波数	f <sub>αb</sub>	V <sub>CB</sub> = 10V I <sub>E</sub> = -0.2A	8MHz Typ. 4MHz Min.			

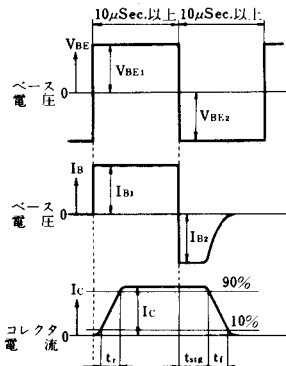
■代表的スイッチング特性 (エミッタ接地)

V <sub>CC</sub> (V)	R <sub>L</sub> (Ω)	I <sub>C</sub> (A)	I <sub>B1</sub> (mA)	I <sub>B2</sub> (mA)	t <sub>r</sub> (μSec.)	t <sub>stg</sub> (μSec.)	t <sub>f</sub> (μSec.)
6	3	2	400	-100	1.2	1.6	1.7

スイッチング特性測定回路



測定条件



周囲温度と最大許容損失

